

トランジスタ

2SD886, 2SD886A

2SD886, 2SD886A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形/Si NPN Triple Diffused Planar

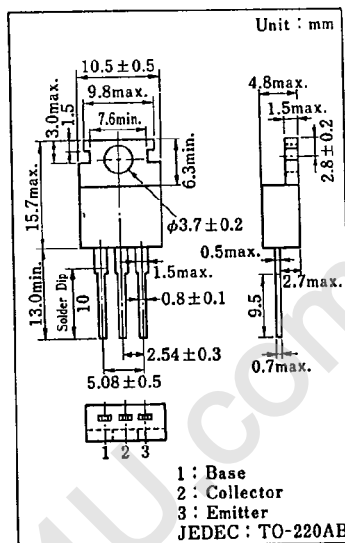
高電流増幅率, 低周波電力増幅用/High h_{FE} , AF Power Amplifier

■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。/High h_{FE}
- h_{FE} の直線性がよい。/Good linearity of h_{FE}

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	80	V
		100	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	6	A
コレクタ電流	I_C	3	A
ベース電流	I_B	1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	40	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 80\text{ V}, I_E = 0$			100	μA
		$V_{CB} = 100\text{ V}, I_E = 0$			100	μA
コレクタ・シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 40\text{ V}, I_B = 0$			100	μA
エミッタ・シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 6\text{ V}, I_C = 0$			100	μA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 25\text{ mA}, I_B = 0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 0.5\text{ A}$	500		1500	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2\text{ A}, I_B = 0.05\text{ A}$			1	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 12\text{ V}, I_C = 0.2\text{ A}$		50		MHz

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	Q	P
h_{FE}	500~1000	800~1500

トランジスタ

2SD886, 2SD886A

T-33-11

